



دستگاه لایه نشانی بخارشیمیایی پلاسمای جریان مستقیم PECVD

شرکت توسعه حسگر سازان آسیا

شرکت توسعه حسگر سازان آسیا یک شرکت تحقیقاتی- صنعتی می باشد که در راستای تحقیقات علمی-دانشگاهی شکل گرفته است. در این شرکت برخی از نتایج علمی-دانشگاهی به مرحله تولید صنعتی و یا نیمه صنعتی خواهند رسید که از آن میان می توان به ساخت حسگرهای مختلف با کاربردهای خاص اشاره نمود.

دستگاه های ساخته شده توسط شرکت حسگر سازان عبارتند از:

- دستگاه لایه نشان بخارشیمیایی فشارپایین
- دستگاه لایه نشانی بخار شیمیایی پلاسمای جریان مستقیم و جریان متناوب
- سیستم زدایش فعال یونی و زدایش عمیق سیلیکون

PECVD دستگاه لایه نشانی بخارشیمیایی پلاسمای جریان مستقیم

یکی از روش های رشد عمودی نانولوله های کربنی استفاده از سیستم لایه نشانی بخار شیمیایی با پلاسمای مستقیم است. شرکت حسگر سازان دارای تجربه ای ۷ ساله در طراحی و ساخت این دستگاه به صورت اختصاصی برای رشد نانولوله ها

است. نمونه اولیه این دستگاه در آزمایشگاه لایه نازک دانشگاه تهران(دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر) موجود می باشد. نمونه های جدید این دستگاه دارای سیستم کنترلی کامپیوتراست که به محققان این امکان را می دهد که پرسوه ها و فرآیندهای پیچیده تری را طراحی و پیاده سازی کنند.

این دستگاه برای لایه نشانی نانولوله های کربنی و هیدروژن دهی پلاسمایی مورد استفاده قرار می گیرد. ناحیه گرمایی داخل محفظه به سه رآکتور تقسیم می گردد و اپراتور قادر است با برنامه ریزی دما، فشار و در صورت نیاز قدرت پلاسما، لایه نشانی و ورود گازها به سیستم را برنامه ریزی کند. برای این دستگاه دو کنترل کننده گاز برای استیلین و هیدروژن در نظر گرفته شده است؛ اما این تعداد می تواند به چهار الی پنج گاز شامل گازهای آمونیاک، اکسیژن و آرگون به مجموعه اضافه گردد. در ضمن سیستم مجهز به یک لوله رآکتور می باشد؛ اما در صورت درخواست مشتری امکان اضافه کردن دو لوله دیگر بصورت موازی با تیوب اولیه نیز در نظر گرفته شده است که به افزایش قابلیتهای دستگاه منجر خواهد شد.

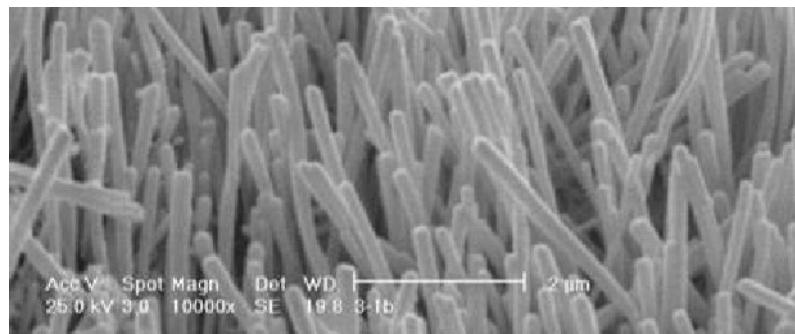
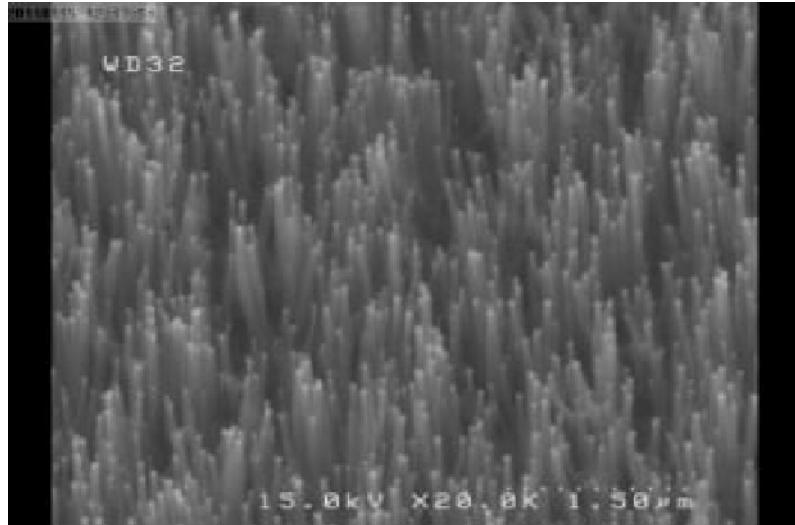
برخی قابلیت های این تجهیز عبارت اند از:

- دمای عملیاتی هر رآکتور بین 500°C - 850°C برای کاربردهای مختلف قابل کنترل است.
- امکان قرار گرفتن نمونه های بصورت موازی وجود دارد.
- علاوه بر امکان رشد نانوساختارها، این تجهیز امکان زدایش یونی در مواد سخت مانند سیلیکون را دارد.
- برنامه کامپیوترا طوری تهیه گردیده که اپراتور از باز و بسته کردن و تنظیم شیرها آسوده باشد و کلیه مراحل عمل دستگاه ببروی نمایشگر به نمایش گذارده شود.
- برای اطمینان از تخلیه خطوط چه قبل و چه بعد از MFC ها از شیرهای بادی از جنس استیل استفاده می گردد تا حد اکثر ایمنی و کیفیت حاصل گردد.
- کلیه درهای سیستم به اینترلاک مجهز می باشند.



مشخصات فنی :

PECVD(SI-PE803)	مدل
۳ عدد محفظه تیوبی از جنس کوارتز به طول ۸۰ سانتیمتر	محفظه فرآیند
۲۰ سانتیمتر وسط راکتور	منطقه مفید حرارتی
۵۰ الی ۸۵۰ درجه سانتیگراد بسته به نوع کاربرد	دماي کاري
دو عدد MFC، شيرها و گيج ها و خطوط گازرسانی از جنس فولاد ضدزنگ	توزيع گازها
استیلن، آمونیا، هیدروژن، اکسیژن، آرگون و ...	نوع گازهای مصرفی
روتاری	پمپ خلاء
در حدود ۸۰ میلی تور بسته به نوع پروسه متغير	فشارپايه
سیستم کنترلی دما	PC/PLC
قابلیت کار با سیستم عامل ویندوز ۷	سیستم کنترلی
فلزی مناسب برای ۱ یا ۲ تیوب	ابعاد فیزیکی
ارتفاع: ۱۷۰ سانتیمتر، عمق: ۱۲۰ سانتیمتر، پهنای ۷۰ سانتیمتر	ابعاد بدنه
۴۰ کیلوگرم	وزن دستگاه
3 KW, 110/220 V, 3 Phase, 20/40 A 1KW/13.56 MHz	توان
منبع پلاسمای RF	توان دستگاه
میکروالکترونیک، NEMS، MEMS، نanosاختارها (نانولوله های کربنی و ...)	كاربردها



تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نانولوله های کربنی سنتز شده توسط دستگاه PECVD

LPCVD



این دستگاه از رکن های اصلی آزمایشگاه هایی است که در زمینه ای نانوالکترونیک و یا سیستم های الکترومکانیکی فعالیت می کنند می باشد. لایه پلی سیلیکان هم به عنوان گیت ترانزیستورها به کارمی رود و هم به عنوان لایه قربانی در فرآیند ماشین کاری بدن. برای زداش کامل قرص سیلیکان و ایجاد غشاء سیلیکانی نیاز به لایه محافظ نیترید سیلیکان می باشد که توسط این دستگاه ایجاد می شود.

این دستگاه برای لایه نشانی Si_3N_4 , SiON , Si در فشارهای پایین استفاده می شود. امکان لایه نشانی سیلیسیم به صورت بی شکل و جند بلوری به کمک این سیستم وجود دارد.

LPCVD (SI-LP80)	مدل
محفظه تیوبی از جنس کوارتز به طول ۸۰ سانتیمتر	محفظه فرآیند
۲۰ سانتیمتر وسط راکتور	منطقه مفید حرارتی
۵۰۰ الی ۸۵۰ درجه سانتیگراد بسته به نوع کاربرد	دما کاری
دوعده MFC، شیرها و گیج ها و خطوط گازرسانی از جنس فولاد ضدزنگ	سیستم گازی
سیلان، آمونیا، هیدروژن، اکسیژن، آرگون و ...	توزیع گازها
روتاری	پمپ خلاء
درحدود ۸۰ میلی تور بسته به نوع پروسه متغیر	فشاربایه
سیستم کنترلی دما	PC/PLC
قابلیت کار با سیستم عامل ویندوز ۷	سیستم کنترلی
فلزی مناسب برای ۱ یا ۲ تیوب	ابعاد فیزیکی
ارتفاع: ۱۷۰ سانتیمتر - عمق: ۱۲۰ سانتیمتر - پهنه: ۷۰ سانتیمتر	ابعاد بدنه
۳۰۰ کیلوگرم	وزن دستگاه
۲ KW, 110/220 V, 3 Phase, 20/40 A	توان دستگاه
میکرو و نانو الکترونیک، MEMS، NEMS	کاربردها

سیستم زدایش فعال یونی و زدایش عمیق سیلیکون (DRIE)

زدایش غیرهمسانگرد به صورت خشک در محیط پلاسمای برای ایجاد ساختارهای مطلوب در سیستم‌های الکترومکانیکی مورد نیاز آزمایشگاه‌هایی است که در زمینه NEMS و MEMS فعالیت می‌کنند.

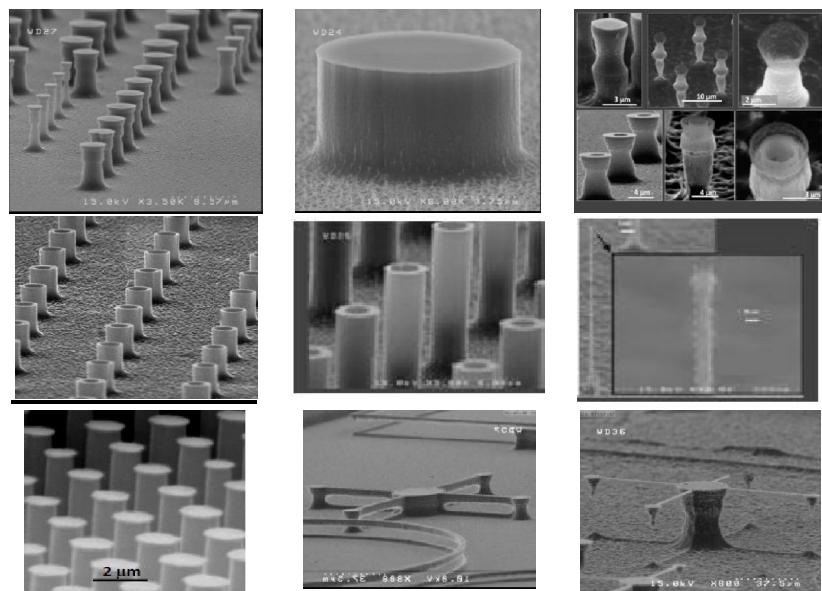
بدین منظور شرکت توسعه حسگر سازان آسیا طراحی این سیستم را به صورت کامل انجام داده و نمونه‌ای از آن نیز در آزمایشگاه لایه نازک دانشگاه تهران در حال سرویس دهی به محققان است.

از قابلیت‌های این دستگاه قابل برنامه ریزی بودن آن است که این امکان را به استفاده کننده می‌دهد تا از آن به عنوان سیستم زدایش عمیق سیلیکان به روشنی که توسط محققین این شرکت طراحی و ثبت شده است استفاده کنند.



مشخصات فنی :

DRIE (SI-HV300)	مدل
سایز و نوع محفظه	محفظه فرآیند
۳۶ * ۳۰ * ۳۸ سانتیمتر، حجم ۲۰ لیتر	
۸۰ میلی تور	فشارپایه
آلومینیوم	نگهدارنده زیرلایه
حداکثر سایز زیرلایه ۴ اینچ	سایز زیرلایه
MFC ها- سیستم خطوط، شیرها از جنس فولاد ضد زنگ- قابلیت	توزیع گازها
حداکثر ۶ خط ورودی گاز	سیستم گازی
پمپ روتاری	سیستم خلاء
۱۰ میلی تور	ظرفیت پمپ مکانیکی
کاربرد دوست با قابلیت کار با سیستم عامل ویندوز ۷	سیستم کنترلی PC/PLC
آهنی	ابعاد فیزیکی
ارتفاع: ۱۰۰ سانتیمتر - عمق: ۹۰ سانتیمتر - پهنا: ۱۰۰ سانتیمتر	جنس بدنه
۲۰۰ کیلوگرم	ابعاد بدنه
5 KW- 3 Phase- 110/220 V 20/40 A 300W/13.56 MHz	وزن دستگاه
توان	توان
توان منبع پلاسمای RF	
نرخ جریان گاز: ۰-۲۰۰ scem	CF4 یا SF6
نرخ جریان گاز: ۰-۵۰۰ scem	O2 , H2, N2
- ایجاد نانو و میکروساختارها- لایه برداری عمودی و عمیق نانومتری- ساخت الگوهای MEMS, NEMS	گازهای مصرفی
نانویی با دقیقت بالا	کاربرد دستگاه



تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از میکروساختارها و نانوساختارهای اج شده توسط دستگاه زدایش عمیق یونی

شرکت توسعه حسگرسازان آسیا

+۹۸ ۲۱ ۷۶۲۵۰۱۶۳-۴	تلفن:
+۹۸ ۲۱ ۶۶۹۶۷۷۹۲	فکس:
www.pnf-co.com	وبسایت:
info@Pnf-co.com	ایمیل: